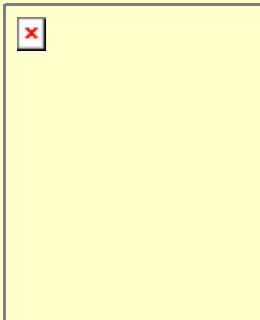


本期封面



1999年4期

栏目:

DOI:

论文题目: 柔性基片上In₂O₃: Sn和ZnO: Al薄膜的制备及其电学和光学特性

作者姓名: 陈猛 白雪冬 黄荣芳 闻立时

工作单位: 中国科学院金属研究所, 沈阳 110015

通信作者: 陈猛

通信作者Email:

文章摘要: 利用直流磁控反应溅射钢锡合金靶和锌合金靶, 在软基片上低温沉积了In₂O₃: Sn (ITO)和ZnO: Al (ZAO)透明电薄膜. 结果表明, ITO和ZAO薄膜均出现晶格畸变; 柔性基片上低温沉积薄膜的电阻率对氧分压的依赖性远低于硅和玻璃衬底; 尺度效应对薄膜电阻率有重要的影响.

关键词: 柔性基片 光学能隙 半导体薄膜 制备

分类号: TN304.21

关闭